

大口径 SiC ウェハ加工技術の最新動向とビジネス展開

200mm口径 SiC ウェハの製造・量産が開始され、これを機に xEV 向けの SiC パワーデバイスの本格量産が始まるとされる。SiC パワーデバイスのさらなる高性能化・高信頼性化、そして低コスト化には、そこで使用されている SiC 単結晶ウェハのさらなる高品質化・低コスト化が必要不可欠である。

本講演会では、日本および世界の企業・大学で 30 年以上、SiC 単結晶ウェハの研究を続けてこられた関西学院大の大谷 昇教授に、SiC 単結晶ウェハの開発状況・ビジネス展開について解説いただくと共に、ウェハ加工の低コスト化のキーテクノロジーであるスライシング技術、研削・研磨技術研究の第一人者に最新技術動向を解説していただき、SiC 単結晶ウェハ開発において今後取り組むべき技術課題を議論する。

主催：公益社団法人 砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

日時：2024 年 12 月 6 日(金)13:00~17:00

開催方式：TKP 東京駅カンファレンスセンター（対面）と Cisco Webex Meeting（Web）のハイブリッド形式で開催します。

〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-8-16 新槇町ビル 1 階

<https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyoeki-central/>

※ 講演者には開催前の状況により、対面か Web のどちらでの講演かを選択して頂きます。

※ Web 開催に関する詳細情報は、参加ご希望の方に後日通知いたします。



13:00~13:05	開会挨拶	委員長 日本大学 山田 高三 氏
13:05~13:55	講演1 「SiC 単結晶ウェハのマーケット及び技術動向」	関西学院大学 大谷 昇 氏
13:55~14:45	講演2 「SiC のファイヤソー切断技術と新加工法への展開」	(株)安永 乾 義孝 氏
14:45~15:05	<休憩>	
15:05~15:55	講演3 「SiC に対するレーザスライシングの実現可能性」	埼玉大学 山田 洋平 氏
15:55~16:45	講演4 「SiC の大口径化と最新研削研磨加工技術」	(株)東京精密 五十嵐 健二 氏
16:45~16:55	閉会挨拶・事務連絡	
17:10~19:10	技術交流会（東京駅付近予定）	

参加費：研究会：当専門委員会会員：無料，非会員：15,400 円（税抜額 14,000 円+消費税 1,400 円），非会員アカデミア：6,600 円（税抜額 6,000 円+消費税 600 円），学生：無料

※会員は 5 人/社まで、非会員は 2 人/社まで研究会に参加できます。

技術交流会：会員資格に関わらず 2 名/社まで参加できます。3 人目からは 4,950 円/人（税抜額 4,500 円+消費税 450 円）を徴収します。

(注)「会員」とは専門委員会会員を指します。学会員ではございませんのでご注意ください。

申込締切日：2024 年 11 月 21 日(木)

(注) 当日キャンセルの非会員には、すでに準備に費用がかかっているため参加費を請求致します。

問合せ/申込先：当専門委員会事務局

・ FAX：048-858-3709，E-mail：sf-office@mech.saitama-u.ac.jp

・ 申し込みはホームページよりお願いいたします。→<https://jsat-sf.jp/event.html>